

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Воронежский государственный технический университет»

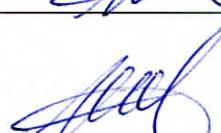
УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета  В.А. Небольсин  
/ /  
«31» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
дисциплины (модуля)  
«Схемотехника аналоговых электронных устройств»

Специальность 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы  
Направленность Радиоэлектронные системы передачи информации  
Квалификация выпускника Инженер  
Нормативный период обучения 5,5 лет  
Форма обучения Очная  
Год начала подготовки 2019 г.

Автор программы  /Худяков Ю.В./

Заведующий кафедрой  
радиоэлектронных устройств  
и систем  /Журавлёв Д.В./

Руководитель ОПОП  /Журавлёв Д.В./

# **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **1.1. Цели дисциплины**

Цель изучения дисциплины: практически и теоретически подготовить будущих специалистов в области разработки структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.

### **Задачи освоения дисциплины**

Формирование у студентов знаний в области разработки структурных, функциональных и принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.

# **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП**

Дисциплина «Схемотехника аналоговых электронных устройств» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 учебного плана.

# **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Процесс изучения дисциплины «Схемотехника аналоговых электронных устройств» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-2 - Способен использовать контрольно-измерительную технику и работать с конструкторской, технической, эксплуатационной документацией

ПК-3 - Способен к проведению диагностики и проверки на работоспособность при эксплуатации составных частей радиоэлектронных систем и комплексов

| <b>Компетенция</b> | <b>Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции</b>   |
|--------------------|--|
| ПК-2               | Знать методы проектирование структурных, функциональных и принципиальных схем с применением современных САПР и пакетов прикладных программ |
|                    | Уметь использовать контрольно-измерительное оборудование для оценки состояния и настройки составных частей радиоэлектронных систем         |
|                    | Владеть автоматизированными системами тестирования   |
| ПК-3               | Знать методы, средства и условия диагностики; Знать алгоритмы выполнения операций по определению одной                                     |

|  |  |
|--|--|
|  | или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта; Знать формы представления данных и методы оценивания точности, достоверности результатов   |
|  | Уметь применять методики оценки максимальной эффективности процесса диагностики для получения результатов с минимальными погрешностями; Уметь проводить диагностику, проверку на работоспособность и оценку функционального состояния составных частей радиоэлектронных систем |
|  | Владеть навыками проектирования, ремонта и обслуживания составных частей радиоэлектронных систем   |

#### **4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Общая трудоемкость дисциплины «Схемотехника аналоговых электронных устройств» составляет 9 зачетных единиц.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

| Вид учебной работы                            | Всего часов | Семестры |     |     |
|---|-------------|----------|-----|-----|
|   |             | 4        | 5   |     |
| <b>Аудиторные занятия (всего)</b>             | 162         | 90       | 72  |     |
| В том числе:                                  |             |          |     |     |
| Лекции  | 54          | 36       | 18  |     |
| Практические занятия (ПЗ)                     | 36          | 18       | 18  |     |
| Лабораторные работы (ЛР)                      | 72          | 36       | 36  |     |
| <b>Самостоятельная работа</b>                 | 117         | 18       | 99  |     |
|   |             |          |     |     |
| Курсовая работа                               | -           | -        | +   |     |
| Контрольная работа                            | -           | -        | -   |     |
| Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен | 45          | +        | 45  |     |
| Общая трудоемкость                            | час         | 324      | 108 | 216 |
|   | зач. ед.    | 9        | 3   | 6   |

#### **5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

## 5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

| № п/п                   | Наименование темы  | Содержание раздела   | Лекц | Прак зан. | Лаб зан. | CPC | Всего, час |
|-------------------------|--|--|------|-----------|----------|-----|------------|
| <b>2 курс 4 семестр</b> |  |  |      |           |          |     |            |
| 1                       | Усилильные устройства  | Основные определения. Классификация усилителей. Структурная схема усилителя.   | 2    | 2         |          | 1   | 5          |
| 2                       | Основные технические показатели усилителей.                        | Коэффициент усиления. Коэффициент полезного действия. Частотная и фазовая характеристики. Частотные искажения. Фазовые искажения. Нелинейные искажения. Амплитудная характеристика. Режимы работы усилительных элементов.  | 2    |           | 4        | 1   | 7          |
| 3                       | Принципы построения усилительных каскадов биполярных транзисторов. | Цепи смещения в каскадах биполярных транзисторов.<br>Стабилизация режима работы усилительных каскадов биполярных транзисторов.   | 2    | 2         |          | 1   | 5          |
| 4                       | Принципы построения усилительных каскадов на полевых транзисторах  | Питание цепей стоков полевых транзисторов. Цепи смещения и стабилизации режима работы в каскадах с полевыми транзисторами  | 2    |           | 4        | 1   | 7          |
| 5                       | Схемы межкаскадной связи в усилителях.                             | Каскады с непосредственной связью. Каскады с резистивно-емкостной связью. Каскады с трансформаторной связью. Параллельные обратные связи в многокаскадных усилителях.  | 2    | 2         |          | 1   | 5          |
| 6                       | Обратные связи в усилителях.                                       | Влияние обратной связи на коэффициент усиления, на частотные искажения, на нелинейные искажения и помехи, на входное и выходное сопротивления. Устойчивость усилителей с обратной связью.  | 2    |           | 4        | 1   | 7          |
| 7                       | Широкополосные усилители.  | Влияние диффузионной емкости и емкости монтажа на АЧХ резистивных усилителей. Методы ВЧ и НЧ коррекции АЧХ.  | 2    | 2         |          | 1   | 5          |
| 8                       | Усилители мощности.  | Однотактные каскады усиления мощности. Однотактный трансформаторный каскад. Однотактный бестрансформаторный каскад. Двухтактные трансформаторные каскады усиления мощности. Трансформаторный двухтактный каскад в режиме А. Трансформаторный двухтактный каскад в режиме АВ. | 2    |           | 4        | 1   | 7          |
| 9                       | Бестрансформаторные двухтактные каскады.                           | Подача смещения в оконечных каскадах усилителей мощности. Предоконечные каскады усилителей мощности. Квазикомплементарный каскад усилителя мощности. Мостовые схемы усилителей мощности.   | 2    | 2         |          | 1   | 5          |
| 10                      | Усилильные каскады специального назначения.                        | Эмиттерный повторитель. Схема эмиттерного повторителя со следящей связью. Истоковый повторитель. Фазоинверсные каскады. Трансформаторный каскад. Каскад с разделенной нагрузкой. Каскодный усилитель.  | 2    |           | 4        | 1   | 7          |
| 11                      | Усилители постоянного тока.  | Токовое зеркало. Источники тока на биполярных транзисторах. Источники тока на полевых транзисторах. УПТ прямого уси-   | 2    | 2         |          | 1   | 5          |

|                                  |  |  |           |           |           |           |
|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |  | ления. Дрейф нуля в УПТ. Методы снижения дрейфа нуля в УПТ. Балансные схемы УПТ. Параллельная балансная схема УПТ. Последовательная балансная схема УПТ. УПТ типа МДМ.   |           |           |           |           |
| 12                               | Операционные усилители ОУ.                     | Идеальный ОУ. Внутренняя структура ОУ. Источники питания ОУ. Коэффициенты усиления. Параметры входной цепи. Параметры выходной цепи.   | 2         | 4         | 1         | 7         |
| 13                               | Типы ОУ.                                       | ОУ общего назначения. Прецизионные ОУ. Быстродействующие ОУ. Микромошные ОУ. Мощные ОУ. Микросхемы ОУ.   | 2         | 2         | 1         | 5         |
| 14                               | Усилильные каскады на основе ОУ.               | Линейные схемы. Нелинейные схемы. Улучшение параметров реальных ОУ. Защита входных цепей ОУ. Защита выходных цепей ОУ. Компенсация входных токов ОУ. Компенсация входного напряжения сдвига ОУ. Увеличение выходной мощности ОУ. Мощные ОУ. Увеличение выходного тока ОУ. Увеличение выходного напряжения ОУ. Использование цепей питания ОУ. Частотная коррекция ОУ. Коррекция по отставанию. | 2         | 4         | 1         | 7         |
| 15                               | Электронные коммутаторы.                       | Аналоговые коммутаторы. Ключи на биполярных транзисторах. Динамические характеристики ключей на биполярных транзисторах и повышение их быстродействия. Ключи на полевых транзисторах. Динамические характеристики ключей на полевых транзисторах и повышение их быстродействия. Ключи на p-i-n диодах.   | 2         | 2         | 1         | 5         |
| 16                               | Регуляторы и стабилизаторы напряжения и тока.  | Линейные регуляторы и стабилизаторы напряжения и тока. Микросхемы линейных регуляторов. Применение ШИМ как основного метода импульсных регуляторов и стабилизаторов напряжения и тока. Чопперная, бустерная, обратноходовая, двухтактная импульсные схемы. Микросхемы импульсных стабилизаторов. Регуляторы переменных напряжений на тиристорах и симисторах                                   | 2         | 4         | 1         | 7         |
| 17                               | Аналоговые формирователи сигналов нужной формы | Пассивные преобразователи: ограничители, сумматоры, перемножители, дифференцирующие, интегрирующие и логарифмирующие цепочки. Функциональные преобразователи на ОУ.  | 2         | 2         | 1         | 5         |
| 18                               | Аналоговые компараторы напряжения              | Характеристики аналоговых компараторов. Простейшие компараторы на операционных усилителях. Компараторы с плавающим порогом. Компараторы на интегральных микросхемах  | 2         | 4         | 1         | 7         |
| <b>Итого за 2 курс 4 семестр</b> |  |  | <b>36</b> | <b>18</b> | <b>36</b> | <b>18</b> |
| <b>3 курс 5 семестр</b>          |  |  |           |           |           |           |
| 19                               | Частотно-избирательные усилители               | Резонансные LC-усилители. Схема на основе параллельного колебательного контура. Схема на основе последовательного колебательного контура. Формирование необходимой АЧХ. Устойчивость резо-   | 2         | 2         | 4         | 10        |
|                                  |  |  |           |           |           | 18        |

|    |  |   |   |   |   |          |
|----|--|---|---|---|---|----------|
|    |  | нансовых усилителей. Применение каскодных усилителей.   |   |   |   |          |
| 20 | Согласование частотно-избирательных усилителей | Согласование с помощью неполного включения в колебательный контур. Особенности согласования мощных резонансных усилителей с нагрузкой. Датчики подводимой мощности и КСВН. Согласование с помощью широкополосных трансформаторах на длинных линиях  | 2 | 2 | 4 | 11<br>19 |
| 21 | Выпрямители и детекторы сигналов.              | Простейший диодный АМ-детектор. Детектор АМ-сигналов с удвоением напряжения. Мостовой диодный АМ-детектор. Линейный АМ-детектор на ОУ. ЧМ-детектор с одиночным контуром. ЧМ-детектора с двумя контурами. Детектор-искриминатор. Дробный ЧМ-детектора (детектор отношений). Балансный фазовый дискриминатор. Кольцевой фазовый дискриминатор.                                | 2 | 2 | 4 | 12<br>20 |
| 22 | Низкочастотные избирательные усилители.        | Квазирезонансные RC-усилители. Усилитель с цепью Вина. Усилитель с ТТ-мостом. Активные фильтры  | 2 | 2 | 4 | 8<br>17  |
| 23 | Основные типы фильтров.                        | Селективный фильтр. Фильтр низких частот. Фильтр высоких частот. Полосовой фильтр. Заграждающий фильтр. Всепропускающий фильтр (фазовый контур). Этапы проектирования активных фильтров. Аппроксимация характеристик фильтров. Структурный синтез активных фильтров. Схема активного фильтра с многоконтурной обратной связью.  | 2 | 2 | 4 | 11<br>19 |
| 24 | Генераторы.                                    | Генераторные каскады с внешним возбуждением. Автогенераторы. Условия самовозбуждения. Мягкое и жесткое самовозбуждение. LC-генераторы. LC-генератор с трансформаторной связью. Трехточечные LC-генераторы. Генераторы на туннельных диодах. RC- генераторы. Генератор с мостом Вина. Генератор с цепочкой Сифорова. Стабилизация амплитуды выходного напряжения генераторов | 2 | 2 | 4 | 13<br>21 |
| 25 | Синтезаторы частоты.                           | Нестабильность LC и RC автогенераторов с параметрической стабилизацией частоты. Кварцевые генераторы. Реализация сетки частот. Получение стабильных по частоте сигналов методом косвенного синтеза. Перестройка частоты при использовании косвенного синтезатора. Прямой синтез частоты.  | 2 | 2 | 4 | 10<br>18 |
| 26 | Аналогово-цифровые преобразователи.            | Общие положения. АЦП параллельного типа. АЦП последовательного приближения. Последовательно-параллельные АЦП конвейерного типа. Сигма-дельта АЦП  | 2 | 2 | 4 | 11<br>19 |
| 27 | Цифро-анalogовые преобразователи.              | Общие положения. ЦАП с суммированием токов. ЦАП с внутренними источниками тока. Сегментированные ЦАП. Цифровые потенциометры. ЦАП прямого цифрового синтеза. Параметры ЦАП  | 2 | 2 | 4 | 13<br>21 |

|   |           |           |           |            |            |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Промежуточный контроль (экзамен)</b> |           |           |           |            | 45         |
| <b>Итого за 3 курс 5 семестр</b>        | 18        | 18        | 36        | 99         | 216        |
| <b>Итого</b>                            | <b>54</b> | <b>36</b> | <b>72</b> | <b>117</b> | <b>324</b> |

## 5.2 Перечень лабораторных работ

| №п/п                             | Наименование лабораторной работы  | Объем часов | Виды контроля |
|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| <b>2 курс 4 семестр</b>          |   |             |               |
| 1                                | Исследование входных и выходных сопротивлений каскадов ОЭ, ОБ и ОК на биполярных транзисторах.  | 4           | защита отчета |
| 2                                | Исследование входных и выходных сопротивлений каскадов ОЭ, ОБ и ОК на полевых транзисторах.   | 4           | защита отчета |
| 3                                | Схемотехническое построение входных и выходных цепей каскадов ОЭ, ОБ и ОК на биполярных транзисторах.   | 4           | защита отчета |
| 4                                | Схемотехническое построение входных и выходных цепей каскадов ОЭ, ОБ и ОК на полевых транзисторах.  | 4           | защита отчета |
| 5                                | Исследование влияния емкостной составляющей со-противления нагрузки резистивного каскада усиления на биполярных и полевых транзисторах на их АЧХ.   | 4           | защита отчета |
| 6                                | Исследование влияния различных вариантов отрица-тельной последовательной обратной связи по току и напряжению на коэффициент усиления и нелинейные искажения резистивного каскада усиления на биполярных и полевых транзисторах. | 4           | защита отчета |
| 7                                | Исследование влияния различных вариантов отрица-тельной обратной связи на коррекцию АЧХ снизу и сверху по частоте резистивного каскада усиления на биполярных и полевых транзисторах.   | 4           | защита отчета |
| 8                                | Исследование двухтактных трансформаторных и бес-трансформаторных каскадов усиления мощности.  | 4           | защита отчета |
| 9                                | Исследование дифференциального каскада усиления на биполярных транзисторах. Различные варианты ис-пользования операционных усилителей.  | 4           | защита отчета |
| <b>Итого за 2 курс 4 семестр</b> |   | 36          |               |
| <b>3 курс 5 семестр</b>          |   |             |               |
| 10                               | Исследование различных вариантов использования операционных усилителей.   | 4           | защита отчета |
| 11                               | Исследование резонансных LC-усилителей.   | 4           | защита отчета |
| 11                               | Исследование квазирезонансных RC-усилителей.  | 4           | защита отчета |
| 12                               | Исследование основных типов пассивных фильтров.   | 4           | защита отчета |
| 13                               | Исследование влияния различных вариантов положи-тельной обратной связи на основные параметры рези-стивного каскада усиления на биполярных и полевых   | 4           | защита отчета |

|                                  |  |    |               |
|----------------------------------|--|----|---------------|
|                                  | транзисторах.  |    |               |
| 14                               | Исследование условия самовозбуждения LC-генератора с трансформаторной связью.                        | 4  | защита отчета |
| 15                               | Исследование автогенераторов по схеме индуктивной трехточки с общими коллектором, базой и эмиттером. | 4  | защита отчета |
| 16                               | Исследование автогенераторов по схеме емкостной трехточки с общими коллектором, базой и эмиттером.   | 4  | защита отчета |
| 17                               | Исследование кварцевых автогенераторов по схеме с общими коллектором, базой и эмиттером.             | 4  | защита отчета |
| 18                               | Исследование релаксационных и квазирезонансных RC генераторов.                                       | 4  | защита отчета |
| <b>Итого за 3 курс 5 семестр</b> |  | 36 |               |
| <b>Итого</b>                     |  | 72 |               |

### 5.3 Перечень практических занятий

| №п/п                             | Тема практического занятия   | Объем часов | Виды контроля |
|----------------------------------|--|-------------|---------------|
| <b>2 курс 4 семестр</b>          |  |             |               |
| 1                                | Нелинейная ВАХ диодов. Статические и динамические сопротивления. Сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединении диодов. | 2           | Устный опрос  |
| 2                                | Формирователи сигналов различной формы на пассивных элементах.   | 2           | Устный опрос  |
| 3                                | Формирователи сигналов различной формы на активных элементах.  | 2           | Устный опрос  |
| 4                                | Диффузионная емкость и емкость коллектор-база биполярных транзисторов. Эффект Миллера.   | 2           | Устный опрос  |
| 5                                | Особенности работы электронных ключей на биполярных и полевых транзисторах.  | 2           | Устный опрос  |
| 6                                | Мощные ключи на тиристорах, симисторах и IGBT транзисторах.  | 2           | Устный опрос  |
| 7                                | Формирователи ШИМ.   | 2           | Устный опрос  |
| 8                                | Линейные и импульсные стабилизаторы напряжения. Использование ШИМ в импульсных стабилизаторах.   | 2           | Устный опрос  |
| 9                                | Аналоговые компараторы напряжения.   | 2           | Устный опрос  |
| <b>Итого за 2 курс 4 семестр</b> |  | 18          | Устный опрос  |
| <b>3 курс 5 семестр</b>          |  |             |               |
| 10                               | Формирование необходимой АЧХ в резонансных LC-усилителях на основе параллельного колебательного контура.                                   | 2           | Устный опрос  |
| 11                               | Детекторы АМ, ЧМ и ФМ сигналов.  | 2           | Устный опрос  |
| 11                               | Способы согласования ВЧ усилителей с нагрузкой . Датчики КСВН.   | 2           | Устный опрос  |

|                                  |   |    |              |
|----------------------------------|---|----|--------------|
| 12                               | Квазирезонансные RC-усилители. Усилитель с цепью Вина. Усилитель с ТТ-мостом. Активные фильтры. Активный фильтр с многоконтурной обратной связью. | 2  | Устный опрос |
| 13                               | . Трехточечные LC-генераторы. Генераторы на туннельных диодах.  | 2  | Устный опрос |
| 14                               | Параметрическая стабилизация частоты LC-генераторов. Кварцевые генераторы.  | 2  | Устный опрос |
| 15                               | Релаксационные RC генераторы. Генератор с мостом Вина.  | 2  | Устный опрос |
| 16                               | Получение стабильных по частоте сигналов методом косвенного синтеза. Перестройка частоты при использовании косвенного синтезатора.                | 2  | Устный опрос |
| 17                               | АЦП параллельного типа. АЦП последовательного приближения.  | 2  | Устный опрос |
| 18                               | ЦАП с суммированием токов.  | 2  | Устный опрос |
| <b>Итого за 3 курс 5 семестр</b> |   | 18 |              |
| <b>Итого</b>                     |   | 36 |              |

## **6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выполнение курсовой работы в 5 семестре.

Примерная тематика курсового проекта: «Проектирование аналоговых электрических схем для радиоэлектронных систем передачи информации»

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:

- с использованием непрерывных функций провести анализ различных алгоритмов решение задачи, представленной в ТЗ на курсовую работу;
- выбрать или синтезировать оптимальный алгоритм реализации ТЗ;
- на основе оптимального алгоритма реализации ТЗ составить функциональную электрическую схему устройства;
- с использованием методов аналоговой схемотехники провести анализ вариантов реализации различных функциональных узлов, представленных в функциональной схеме;
- выбрать или синтезировать оптимальный вариант схемотехнического построения функциональных узлов с использованием методов аналоговой схемотехники;
- провести соответствующие расчеты и моделирование с использованием средств вычислительной техники.

## **7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

### **7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

#### **7.1.1 Этап текущего контроля**

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

| Компетенция | Результаты обучения,, характеризующие сформированность компетенции  | Критерии оценивания  | Аттестован  | Не аттестован   |
|-------------|---|--|---|---|
| ПК-2        | Знать методы проектирование структурных, функциональных и принципиальных схем с применением современных САПР и пакетов прикладных программ  | Активная работа на практических занятиях, вовремя выполняет и отчитывается по лабораторным работам                                 | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |
|             | Использовать контрольно-измерительное оборудование для оценки состояния и настройки составных частей радиоэлектронных систем  | Решение стандартных практических задач, верные ответы при защите отчета по лабораторным работам                                    | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |
|             | Владеть автоматизированными системами тестирования  | Решение прикладных задач в конкретной предметной области, верные выводы по результатам экспериментальных данных лабораторных работ | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |
| ПК-3        | Знать методы, средства и условия диагностики; Знать алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта; Знать формы представления данных и методы оценивания точности, достоверности результатов | Активная работа на практических занятиях, вовремя выполняет и отчитывается по лабораторным работам                                 | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | Уметь применять методики оценки максимальной эффективности процесса диагностики для получения результатов с минимальными погрешностями; Уметь проводить диагностику, проверку на работоспособность и оценку функционального состояния составных частей радиоэлектронных систем | Решение стандартных практических задач, верные ответы при защите отчета по лабораторным работам                                    | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |
|  | Владеть навыками проектирования, ремонта и обслуживания составных частей радиоэлектронных систем   | Решение прикладных задач в конкретной предметной области, верные выводы по результатам экспериментальных данных лабораторных работ | Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах | Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах |

### 7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре по системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

| Компетенция | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции   | Критерии оценивания | Отлично                     | Хорошо                     | Удовл                      | Неудовл                              |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ПК-2        | Знать методы проектирование структурных, функциональных и принципиальных схем с применением современных САПР и пакетов прикладных программ  | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|             | Использовать контрольно-измерительное оборудование для оценки состояния и настройки составных частей радиоэлектронных систем  | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|             | Владеть автоматизированными системами тестирования  | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
| ПК-3        | Знать методы, средства и условия диагностики; Знать алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта; Знать формы представления данных и методы оценивания точности, достоверности результатов | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |

|  |  |      |                             |                            |                            |                                      |
|--|--|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|  | Уметь применять методики оценки максимальной эффективности процесса диагностики для получения результатов с минимальными погрешностями; Уметь проводить диагностику, проверку на работоспособность и оценку функционального состояния составных частей радиоэлектронных систем | Тест | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|  | Владеть навыками проектирования, ремонта и обслуживания составных частей радиоэлектронных систем   | Тест | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре по системе:

- «отлично»;
- «хорошо»;
- «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно».

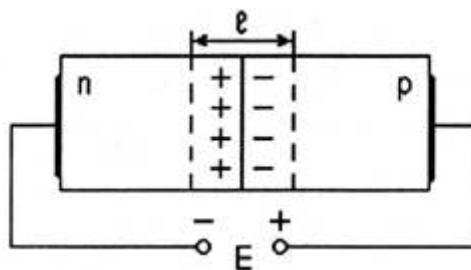
| Компетенция | Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции  | Критерии оценивания | Отлично                     | Хорошо                     | Удовл                      | Неудвл                               |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ПК-2        | Знать методы проектирование структурных, функциональных и принципиальных схем с применением современных САПР и пакетов прикладных программ   | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|             | Использовать контрольно-измерительное оборудование для оценки состояния и настройки составных частей радиоэлектронных систем   | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|             | Владеть автоматизированными системами тестирования   | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
| ПК-3        | Знать методы, средства и условия диагностики; Знать алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта; Знать формы представления данных и методы оценивания точности, достоверности результатов                  | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|             | Уметь применять методики оценки максимальной эффективности процесса диагностики для получения результатов с минимальными погрешностями; Уметь проводить диагностику, проверку на работоспособность и оценку функционального состояния составных частей радиоэлектронных систем | Тест                | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |

|  |  |      |                             |                            |                            |                                      |
|--|--|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|  | Владеть навыками проектирования, ремонта и обслуживания составных частей радиоэлектронных систем | Тест | Выполнение теста на 90-100% | Выполнение теста на 80-90% | Выполнение теста на 70-80% | В тесте менее 70% правильных ответов |
|--|--|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|

## 7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

### 7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Как изменятся свойства p-n перехода, если к нему подключить источник E, напряжением 0,8 В, в указанной на схеме полярности:



- а) Не изменяются;
- б) Переход запирается;
- в) Увеличится толщина p-n перехода.
- г) Увеличится электропроводность p-n перехода.

2. Какие полупроводниковые приборы применяются для преобразования переменного напряжения в униполярное?

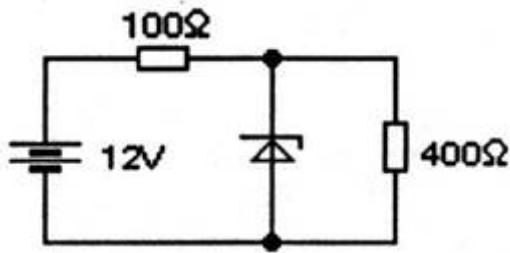
- а) Варикапы.
- б) Плоскостные диоды.
- в) Стабилитроны.
- г) Динисторы.

3. Какие полупроводниковые приборы применяются для получения неизменяющегося напряжения в нагрузке?

- а) Динисторы.
- б) Тиристоры.
- в) Стабилитроны.
- г) Варикапы.

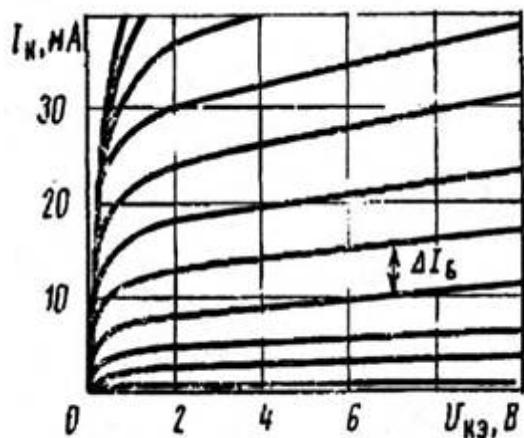
4. В приведенной схеме использован стабилитрон с параметрами:

$U_{ct} = 8 \text{ В}$ ,  $I_{ct,\min} = 10 \text{ мА}$ ,  $I_{ct,\max} = 160 \text{ мА}$ . Какой ток протекает через стабилитрон?



- a) 20 мА
- б) 40 мА
- в) 75 мА
- г) 120 мА

5. Определите по вольт-амперным характеристикам статический коэффициент передачи тока транзистора ( $B_{ct}$ ) в схеме ОЭ для точки покоя с параметрами  $I_{кп} = 15$  мА,  $U_{кп} = 6$  В, если шаг тока базы  $\Delta I_b = 100$  мкА



- а)  $B_{ct} > 150$
- б)  $B_{ct} > 60$
- в)  $B_{ct} > 30$
- г)  $B_{ct} > 600$

## 7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

1. Какой параметр усилителя вычисляется по формуле  $F = 1 + \beta K$  ?
  - а) Коэффициент усиления по напряжению.
  - б) Динамический диапазон.
  - в) Коэффициент гармоник.
  - г) Глубина обратной связи.
2. Что характеризует полоса пропускания усилителя?

- а) Диапазон частот усиливаемого сигнала.  
 б) Диапазон уровней напряжения входного сигнала.  
 в) Диапазон регулирования громкости выходного сигнала.  
 г) Нет правильного.  
 3. Какое преимущество имеют усилители класса В перед усилителями класса А?  
 а) Меньший уровень нелинейных искажений.  
 б) Больше коэффициент полезного действия.  
 в) Шире полоса пропускания.  
 г) Больше коэффициент усиления по напряжению.  
 4. Какой вид обратной связи не встречается в усилителях электрических сигналов?  
 а) Последовательная по току.  
 б) Параллельная по напряжению.  
 в) Последовательная по фазе.  
 г) Отрицательная по напряжению.

5. Для какого усилителя справедливо выражение  $K_U = K_{U1} \cdot K_{U2}$

- а) Для двухтактного трансформаторного усилителя.  
 б) Для двухтактного бестрансформаторного усилителя.  
 в) Для двухкаскадного усилителя.  
 г) Все правильные.

6. Для какого усилителя справедливо выражение  $K_U = K_{U1} \cdot K_{U2}$

- а) Для двухтактного трансформаторного усилителя.  
 б) Для двухтактного бестрансформаторного усилителя.  
 в) Для двухкаскадного усилителя.  
 г) Все правильные.

### 7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1. Середине линейного участка проходной характеристики полевого МОП транзистора n-типа соответствует напряжение смещения

1. (-0.1 ... -0.3) В
2. (0.1 ... 0.3) В
3. (-0.6 ... -0.8) В
4. (0.6 ... 0.8) В
5. (-1 ... -6) В
6. (1 ... 6) В
7. (-2 ... 2) В

2. Какой системе параметров четырехполюсника соответствуют уравнения (знаком # обозначен искомый параметр)?

$$U_1 = \#_{11} \cdot I_1 + \#_{12} \cdot U_2, \quad I_2 = \#_{21} \cdot I_1 + \#_{22} \cdot U_2$$

3. Какой системе параметров четырехполюсника соответствуют уравнения (знаком # обозначен искомый параметр)?

$$I_1 = \#_{11} \cdot U_1 + \#_{12} \cdot U_2, \quad I_2 = \#_{21} \cdot U_1 + \#_{22} \cdot U_2$$

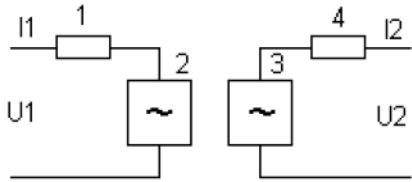
4. Какой системе параметров четырехполюсника соответствуют уравнения (знаком # обозначен искомый параметр)?

$$U_1 = \#_{11} \cdot I_1 + \#_{12} \cdot I_2, \quad U_2 = \#_{21} \cdot I_1 + \#_{22} \cdot I_2$$

5. Какой системе параметров четырехполюсника соответствуют уравнения (знаком # обозначен искомый параметр)?

$$I_1 = \#_{11} \cdot U_1 + \#_{12} \cdot I_2, \quad I_2 = \#_{21} \cdot U_1 + \#_{22} \cdot U_2$$

6. Расставьте обозначения в эквивалентной схеме четырехполюсника



#### 7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Параметры усилителя. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики идеального усилителя. Классификация реальных усилителей по виду амплитудно-частотной характеристики. Линейные искажения.
2. Переходная характеристика идеального усилителя. Переходная характеристика реального усилителя.
3. Нелинейные искажения. Коэффициент гармоник. Амплитудная характеристика. Динамический диапазон.
4. Режимы работы усилителей:  $A, B, AB, C$  и  $D$ . Выбор рабочей точки. Область применения режимов.
5. Обратная связь в усилителях: классификация.
6. Последовательная положительная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, коэффициент усиления по напряжению, самовозбуждение усилителя.
7. Последовательная отрицательная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, коэффициент усиления по напряжению.
8. Последовательная отрицательная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, стабильность коэффициента усиления, полоса пропускания усилителя.
9. Последовательная отрицательная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, входное сопротивление, выходное сопротивление, нелинейные искажения.
10. Последовательная отрицательная обратная связь по току: структурная схема усилителя, влияние на параметры усилителя.
11. Параллельная отрицательная обратная связь по напряжению: структурная схема усилителя, влияние на параметры усилителя.
12. Параллельная отрицательная обратная связь по току: структурная схема усилителя, влияние на параметры усилителя.
13. Каскад с общим эмиттером: выбор режима работы.
14. Каскад с общим эмиттером: схема с фиксированным током базы, расчет сопротивления в цепи базы.
15. Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы.

Каскад с общим эмиттером: схема с отрицательной обратной связью по напряжению на коллекторе.

17. Каскад с общим эмиттером: схема с фильтром в цепи питания.

18. Каскад с общим эмиттером: схема с эмиттерной стабилизацией режима работы и с фильтром в цепи питания.

19. Каскад с общим эмиттером: схема замещения, входное сопротивление, выходное сопротивление (выразить через параметры схемы замещения).

20. Каскад с общим эмиттером: схема замещения, коэффициент усиления по напряжению, коэффициент усиления по току (выразить через параметры схемы замещения).

21. Каскад с общей базой: принципиальная схема, параметры каскада по переменному току (сравнить с параметрами каскадов с общим эмиттером и общим коллектором).

22. Каскад с общим коллектором: принципиальная схема, параметры каскада по переменному току (сравнить с параметрами каскадов с общим эмиттером и общей базой).

23. Каскад с общим истоком на транзисторах с управляющим  $p-n$ -переходом на транзисторах МДП-структуры: принципиальные схемы, выбор и задание режима работы.

24. Каскад с общим истоком: схема замещения для области средних частот, входное сопротивление, выходное сопротивление, коэффициент усиления по напряжению.

25. Каскад с общим стоком: принципиальная схема, схема замещения, коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление, выходное сопротивление.

26. Схема замещения усилителя для области средних частот. Коэффициент усиления усилителя в области средних частот.

27. Схема замещения усилителя для области низких частот. Амплитудночастотная и фазочастотная характеристики усилителя в области низких частот.

28. Схема замещения усилителя для области высоких частот. Амплитудночастотная и фазочастотная характеристики усилителя в области высоких частот.

29. Выходные каскады усилителей: однотактный трансформаторный каскад в режиме  $A$ .

30. Выходные каскады усилителей: двухтактный трансформаторный каскад.

### **7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену**

1. Резонансные LC-усилители.
2. Схема на основе параллельного колебательного контура.
3. Схема на основе последовательного колебательного контура.
4. Формирование необходимой АЧХ.
5. Устойчивость резонансных усилителей.
6. Применение каскодных усилителей.

7. Согласование с помощью неполного включения в колебательный контур.
8. Особенности согласования мощных резонансных усилителей с нагрузкой.
9. Датчики подводимой мощности и КСВН.
10. Согласование с помощью широкополосных трансформаторах на длинных линиях
11. Простейший диодный АМ-детектор.
12. Детектор АМ-сигналов с удвоением напряжения.
13. Мостовой диодный АМ-детектор.
14. Линейный АМ-детектор на ОУ.
15. ЧМ-детектор с одиночным контуром. ЧМ-детектора с двумя контурами.
16. Детектор-искриминатор.
17. Дробный ЧМ-детектора (детектор отношений).
18. Балансный фазовый дискриминатор.
19. Кольцевой фазовый дискриминатор
20. Квазирезонансные RC-усилители.
21. Усилитель с цепью Вина.
22. Усилитель с ТТ-мостом.
23. Активные фильтры
24. Селективный фильтр.
25. Фильтр низких частот.
26. Фильтр высоких частот.
27. Полосовой фильтр.
28. Заграждающий фильтр.
29. Всепропускающий фильтр (фазовый контур).
30. Этапы проектирования активных фильтров.
31. Аппроксимация характеристик фильтров.

### **7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации (зачет )**

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре по системе:

«аттестован»;  
«не аттестован».

Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 5 вопросов, 5 стандартных задач и 5 прикладных задач. Каждый правильный ответ на вопрос в teste оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных баллов – 15.

1. Студент считается аттестованным в случае, если он набрал 10 баллов и более.
2. Студент считается неаттестованным в случае, если он набрал менее 10 баллов.

### **7.2.7 Паспорт оценочных материалов для промежуточного контроля**

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины                          | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства   |
|-------|---|---|--|
| 1     | Усилительные устройства   | ИД-1 <sub>ПК-2.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 2     | Основные технические показатели усилителей                        | ИД-3 <sub>ПК-3.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 3     | Обратные связи в усилителях                                       | ИД-1 <sub>ПК-3.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 4     | Принципы построения усилительных каскадов биполярных транзисторов | ИД-2 <sub>ПК-2.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 5     | Принципы построения усилительных каскадов на полевых транзисторах | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 6     | Схемы межкаскадной связи в усилителях                             | ИД-2 <sub>ПК-3.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 7     | Широкополосные усилители  | ИД-2 <sub>ПК-2.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 8     | Усилители мощности  | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 9     | Бестрансформаторные двухтактные каскады                           | ИД-3 <sub>ПК-2.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 10    | Усилительные каскады специального назначения                      | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 11    | Усилители постоянного тока  | ИД-2 <sub>ПК-2.</sub>                         | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 12    | Операционные усилители ОУ   | ИД-3 <sub>ПК-2</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |

|    |  |                       |   |
|----|--|-----------------------|---|
| 13 | Типы ОУ  | ИД-2 <sub>ПК-2.</sub> | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен  |
| 14 | Усилительные каскады на основе ОУ              | ИД-3 <sub>ПК-3.</sub> | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен  |
| 15 | Электронные ключи                              | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>  | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен  |
| 16 | Регуляторы и стабилизаторы напряжения и тока   | ИД-2 <sub>ПК-2.</sub> | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен  |
| 17 | Аналоговые формирователи сигналов нужной формы | ИД-3 <sub>ПК-3.</sub> | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен  |
| 18 | Аналоговые компараторы напряжения              | ИД-2 <sub>ПК-2.</sub> | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамена |

### **7.2.8 Методика выставления оценки при проведении промежуточной (итоговой) аттестации (экзамена)**

Студенты, не отчитавшиеся по лабораторным работам и практическим занятиям, к экзамену не допускаются.

Время и место проведения экзамена указывается в расписании экзаменационной сессии.

Раздаются билеты с тремя вопросами. В первом вопросе проверяются знания по принципам функционирования однокаскадных устройств, во втором - многокаскадных (включая микросхемы) согласно требованиям компетенций ПК-2. Третий вопрос содержит по 5 тестов из заданий для подготовки к тестированию, заданий для решения стандартных задач, заданий для решения прикладных задач. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных баллов – 15.

Оценка «Неудовлетворительно» по третьему вопросу ставится в случае, если студент набрал менее 8 баллов, «Удовлетворительно» - от 8 до 10 баллов, «Хорошо» - от 11 до 13 баллов, «Отлично» - от 14 до 15 баллов.

По первым двум вопросам используется устный метод контроля. Время подготовки 30 мин. Время ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы не менее 30 минут. Подготовка выполняется с использованием справочной литературы и средств коммуникации.

При промежуточном (итоговом) контроле в форме экзамена на оценку «отлично» могут претендовать студенты, демонстрирующие знание теоретиче-

ского материала, способные ответить по меньшей мере на 80% вопросов преподавателя и Оценку «хорошо» заслуживают студенты, демонстрирующие знание наиболее важных положений теоретического материала, способные ответить по меньшей мере 60% вопросов преподавателя и самостоятельно решать задачи невысокой сложности. Оценку «удовлетворительно» получают студенты, демонстрирующие знание наиболее важных положений теоретического материала, способные ответить, как минимум, на 40% вопросов преподавателя. При более низкой результативности студент получает оценку «неудовлетворительно».

### **7.2.7 Паспорт оценочных материалов для итогового контроля**

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины       | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства   |
|-------|--|---|--|
| 1     | Частотно-избирательные усилители               | ИД-2 <sub>ПК-2</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 2     | Согласование частотно-избирательных усилителей | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 3     | Выпрямители и детекторы сигналов               | ИД-2 <sub>ПК-2</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 4     | Низкочастотные избирательные усилители         | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 5     | Основные типы фильтров                         | ИД-3 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 6     | Генераторы                                     | ИД-3 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 7     | Синтезаторы частоты                            | ИД-2 <sub>ПК-2</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 8     | Аналогово-цифровые преобразователи             | ИД-1 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, экзамен |
| 9     | Цифро-аналоговые преобразователи               | ИД-3 <sub>ПК-3</sub>                          | Тест, устный опрос, отчет по лабораторным работам и практическим занятиям, эк-     |

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | замен |
|--|--|--|-------|

### **7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Допуск к выполнению лабораторной работе осуществляется непосредственно перед ее выполнением и проводится в форме опроса студента по соответствующим пунктам, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 5 минут.

Захист лабораторной работы осуществляется на следующем занятии согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 10 минут.

Контроль за выполнением курсовой работы осуществляется в течении всего семестра в заранее оговоренное время. На каждом этапе обсуждается представленная студентом информация (обычно содержание одного из разделов курсовой работы), и фиксируется процент выполнения плана выполнения данной работы. Защита курсовой работы осуществляется в форме беседы и оценивается на основании ритмичности его выполнения, оформления, а также правильности ответов на поставленные вопросы в процессе защиты работы.

## **8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

1. Воробьева, Е.И. Электроника и схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Электрон. текстовые дан. ( 4770 Кб; 7040 Кб). - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный технический университет", 2007. - 1 файл. - 30-00.
2. Воробьева Е.И. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - Электрон. текстовые, граф. дан. (2,33 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет", 2012. - 1 файл. - 30-00.
3. Жеребцов, И.П. Основы электроники. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. - 352 с. : ил.
4. Павлов, В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств : Учебник для вузов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2003. - 320 с.
5. Хоровиц, П. Искусство схемотехники : Пер. с англ. / П.Хоровиц, У.Хилл. - 6-е изд. - М. : Мир, 2001. - 704 с. : ил.
6. Горбатенко, В.В. Практические занятия и курсовое проектирование по дисциплине "Схемотехника аналоговых электронных устройств" [Электронный ресурс] : учебное пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. радиотехники. - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2017. - 107 с. : ил.
7. Методические указания к лабораторным работам № 1-4 по дисциплине "Схемотехника аналоговых электронных устройств" для студентов специальности 210302 "Радиотехника" очной, заочной иочно-заочной форм обучения [Электронный ресурс] / Каф. радиотехники; Сост.: Е. И. Воробьева, Д. В. Асотов. - Электрон. текстовые, граф. дан. ( 822 Кб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет", 2011. - 1 файл. - 00-00.

**8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Офисный пакет Microsoft Office, EWB5.12, «MathCad».**

## **9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Аудитория для проведения лекций и практических (лабораторных) занятий</b></p> <p><b>229/3</b></p> | <p>Специализированная лаборатория, оснащенная доской, мультимедиа проектором и компьютером (ноутбук) для лекционных демонстраций, плакатами и пособиями по профилю. Аудитория оснащена компьютерами с возможностью выхода в локальную сеть Интернет</p> |
|---|---|

## **10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

По дисциплине «Схемотехника аналоговых электронных устройств» читаются лекции, проводятся практические занятия, выполняется курсовой проект.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета элементов аналоговых схем . Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной работы студенты получают на занятиях.

Лабораторные работы направлены на приобретение практических навыков для анализа и синтеза аналоговых электрических схем. Допуск к выполнению лабораторной работе осуществляется непосредственно перед ее выполнением и проводится в форме опроса студента по соответствующим пунктам, описанным в методических материалах. Примерное время допуска на одного студента составляет 5 мин

Защита лабораторной работы осуществляется на следующем занятии согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 10 мин.

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной работы студенты получают на занятиях.

Освоение дисциплины оценивается на зачете и экзамене.

| Вид учебных занятий  | Деятельность студента   |
|----------------------|---|
| <p><b>Лекция</b></p> | <p>Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и</p> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.   |
| Практические занятия  | Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение текстовых документов по ЕСКД.   |
| Лабораторные работы   | Подготовка к выполнению лабораторной работы путем изучения содержания соответствующего методического пособия. Подготовка заготовки отчета по лабораторной работе. Изучение соответствующего теоретического материала по тематике лабораторной работы. Получение допуска к выполнению лабораторной работе в процессе беседы с преподавателем по методике проведения работы. Выполнение экспериментальной части работы. Оформление отчета и его защиты. |
| Подготовка к зачету   | При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, решение задач на практических занятиях и отчеты по лабораторным работам   |
| Подготовка к экзамену | При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, отчеты по лабораторным работам и решение задач на практических занятиях.  |

**АННОТАЦИЯ**  
к рабочей программе дисциплины  
**«Схемотехника аналоговых электронных устройств»**

**Направление подготовки** (специальность) 11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы

**Профиль** (специализация) Радиоэлектронные системы передачи информации

**Квалификация выпускника** инженер

**Нормативный период обучения** 5 лет 6 месяцев

**Форма обучения** Очная

**Год начала подготовки** 2019 г.

**Цель изучения дисциплины:** практически и теоретически подготовить будущих специалистов в области разработки структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.

**Задачи освоения дисциплины:**

Формирование у студентов знаний в области разработки структурных, функциональных и принципиальных схем радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ.

**Перечень формируемых компетенций:**

ПК-2 - Способен использовать контрольно-измерительную технику и работать с конструкторской, технической, эксплуатационной документацией

ПК-3 - Способен к проведению диагностики и проверки на работоспособность при эксплуатации составных частей радиоэлектронных систем и комплексов

**Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 9 з.е.**

**Форма итогового контроля по дисциплине:** «экзамен»